

单晶N型硅片(G12)

210X210



几何参数

边宽	210±0.25mm
对角线	295mm, 公差±0.25mm
厚度	130±8μm
弧长投影	1.41±0.5mm

电学性能

电阻率	0.9-1.6Ω·cm
少子寿命	≥1300μs
氧含量	≤10.5ppma
碳含量	≤1ppma

材料性能

生长方法	CZ(拉直)法
晶向	<100>±2°

表面性能

TTV	≤20
翘曲度	≤40
线痕	≤13
边缘崩边	深度≤0.3mm,长度≤0.5mm,不多于一处
裂纹和穿孔	目测不可见
硅片表面	干净, 无油污、肥皂和胶水等残留物